微小球キャビティと光機械結合した化合物半導体ナノワイヤ

A compound semiconductor nanowire optomechanically coupled to a microsphere cavity ¹NTT 物性基礎研、²NTT ナノフォトニクスセンタ 浅野 元紀 ¹, 章 国強 ^{1,2}, 俵 毅彦 ^{1,2},

山口 浩司¹, ○岡本 創¹

¹NTT BRL, ²NTT NPC Motoki Asano¹, Guoqiang Zhang^{1,2}, Takehiko Tawara^{1,2},

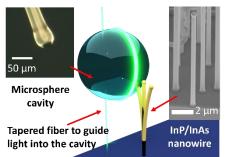
Hiroshi Yamaguchi1 and OHajime Okamoto1

E-mail: hajime.okamoto.sd@hco.ntt.co.jp

超軽量で超小型な半導体ナノワイヤは、ナノフォトニクスやナノエレクトロニクスの分野のみ ならず、ナノメカニクスの分野においても注目される。とりわけ、エピタキシャル成長により形 成される III-V 族半導体ナノワイヤは、内部に組み込む量子へテロ構造の調整により、光共鳴波長 を広範囲で任意設定できる特徴があり [1]、さらには量子構造と機械振動との歪を介した結合が 可能となる[2]。このような III-V 族半導体ナノワイヤは、フォノン・フォトン・エレクトロンを結 び付ける新規ハイブリッド量子系として期待されるが、電気容量が小さく光反射の弱いナノワイ ヤ構造において、その微小な機械振動(フォノン)を高感度に読み取り、これを制御するのは容 易ではない。この問題を解決する手法の一つとして、光キャビティの融合による"キャビティオ プトメカニクス[3]"の適用が期待されるが、ナノワイヤ機械振動子への光キャビティの融合は、 サイズ相違の観点からこれまで殆ど実現されていない。

本研究では、直径 40 μm のシリカ微小球キャビティと結合した InP/InAs ナノワイヤ機械振動子 (長さ 14 μm、直径 500 nm) を報告する (Fig.1)。この系では、微小球キャビティのウィスパリン グギャラリーモードとナノワイヤの機械振動モードとが近接場を介して光機械結合する。微小球 キャビティはピエゾポジショナを用いた空間位置制御が可能であるため、キャビティとナノワイ ヤのギャップ間隔を調節し、光機械結合の大きさを制御することが可能である。我々は、光キャ ビティを用いたナノワイヤ熱振動の高感度ホモダイン検出 (Fig. 2)、並びに、共振周波数と線幅の 変調および振動軸の回転制御に成功した。今回実験で使用した光キャビティのQ値は1.8 x 105で あるが、Q 値を一桁改善することにより、量子極限におけるナノワイヤの超高感度振動検出とフ ォノン制御が視野に入る。このナノワイヤ系におけるキャビティオプトメカニクスをエピタキシ ャル結晶設計技術と組み合わせることにより、様々な量子ナノ構造との組み合わせに基づく量子 オプトエレクトロメカニクスへの展開が期待される。

- [1] G. Zhang et. al., Sci. Adv. 5, eaat8896 (2019). [2] M. Munsch et. al., Nat. Commun. 8, 1 (2017).
- [3] M. Aspelmeyer, T. J. Kippenberg, and F. Marquardt, Rev. of Mod. Phys. 86, 1391 (2014).



Conceptual illustration of near-field optomechanical coupling between an optical the two orthogonalized mode of the nanowire microsphere and InP/InAs nanowire together with measured by balanced homodyne interferometry. optical and electron scanning micrographs.

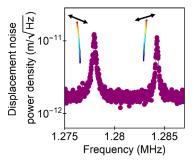


Fig.2 Thermomechanical noise power spectrum of